

SYD2065SLA、SYD2065SLP、SYD2065SLB、SYD2065SLD、系列是 20A，650V 高可靠性 IGBT 晶体管，具有低的导通损耗和开关损耗等特点。该产品可应用于 UPS、PFC、电机控制等领域。

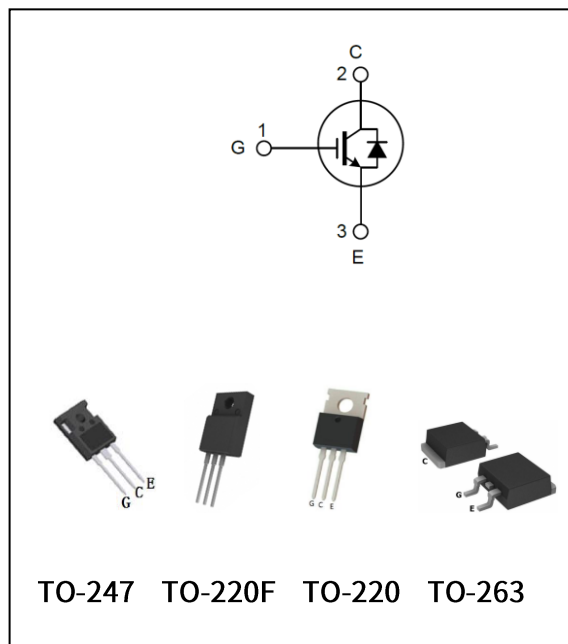
主要特征:

- 20A，650V， $V_{CE(sat)}=1.7V @ I_C=20A$
- 饱和压降为正温度系数，易于并联使用
- 低导通损耗
- 内置快恢复二极管
- 高可靠性及热稳定性，良好的参数一致性

产品规格分类:

型号 #	打标名称	封装
SYD2065SLA	SYD2065SLA	TO-247
SYD2065SLP	SYD2065SLP	TO-220
SYD1565SLB	SYD2065SLB	TO-220F
SYD2065SLD	SYD2065SLD	TO-263

封装符号:



极限参数 (除非另有说明, $T_A = 25^\circ C$):

符号	参数	参数范围	单位
V_{CE}	集电极—发射极电压	650	V
V_{GE}	栅极-发射极电压	± 20	V
I_C	集电极电流 ($T_C=25^\circ C$)	40	A
	集电极电流 ($T_C=100^\circ C$)	20	A
I_{Cpuls}	集电极脉冲电流	60	A
I_{Fpuls}	二极管脉冲电流	45	A
t_{sc}	短路耐受时间 $V_{CE} \leq 300V, V_{GE}=15V$, 间隔时间 $\geq 1s$	5	μs

P_{tot}	耗散功率 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$) ~ TO-247	136	W
	耗散功率 ($T_c=100^{\circ}\text{C}$) ~ TO-247	68	
P_{tot}	耗散功率 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$) ~ TO-263	115	W
	耗散功率 ($T_c=100^{\circ}\text{C}$) ~ TO-263	58	
P_{tot}	耗散功率 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$) ~ TO-220	158	W
	耗散功率 ($T_c=100^{\circ}\text{C}$) ~ TO-220	79	
P_{tot}	耗散功率 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$) ~ TO-220F	56	W
	耗散功率 ($T_c=100^{\circ}\text{C}$) ~ TO-220F	27	
T_J	最高结温	-55~175	$^{\circ}\text{C}$
T_{STG}	存储温度	-55~175	$^{\circ}\text{C}$
R_{thjc}	IGBT芯片至管壳热阻 TO-247	1.1	K/W
	IGBT芯片至管壳热阻 TO-263	1.3	
	IGBT芯片至管壳热阻 TO-220	0.95	
	IGBT芯片至管壳热阻 TO-220F	2.8	
R_{thjcd}	体二极管芯片至管壳热阻 TO-247	2.5	
	体二极管芯片至管壳热阻 TO-263	3.1	
	体二极管芯片至管壳热阻 TO-220	2.6	
	体二极管芯片至管壳热阻 TO-220F	5.8	
R_{thjA}	结到空气热阻 TO-247	40	
	结到空气热阻 TO-263	62	
	结到空气热阻 TO-220	62	
	结到空气热阻 TO-220F	62.5	

表 1: 极限参数

电气参数(除非另有说明, $T_A = 25^\circ\text{C}$):

符号	参数	最小	典型	最大	单位	测试条件
B_{VCE}	集射极击穿电压	650	---	---	V	$V_{GE}=0V, I_C=100\mu A$
I_{CES}	集射漏电流	---	---	40	μA	$V_{CE}=650V, V_{GE}=0V$
I_{GES}	栅射漏电流	---	---	± 100	nA	$V_{GE}=20V, V_{CE}=0V$
$V_{GE(th)}$	栅极开启电压	4.0	5.5	7.0	V	$I_C=250\mu A, V_{CE}=V_{GE}$
$V_{CE(sat)}$	导通饱和压降	---	1.7	2.1	V	$I_C=20A, V_{GE}=15V$
$V_{CE(sat)}$		---	2.0	---	V	$I_C=20A, V_{GE}=15V, T_C=125^\circ\text{C}$
C_{ies}	输入电容	---	1170	---	pF	$V_{CE}=30V$ $V_{GE}=0V$ $f=1\text{MHz}$
C_{oes}	输出电容	---	72.0	---	pF	
C_{res}	反向传输电容	---	34.0	---	pF	
Q_g	栅电荷	---	57	---	nC	$V_{CE}=400V,$ $I_C=20A,$ $V_{GE}=15V$
Q_{ge}	发射极栅电荷	---	5.9	---	nC	
Q_{gc}	集电极栅电荷	---	30	---	nC	

表 2: IGBT 电气参数

FRD 电气参数(除非另有说明, $T_A = 25^\circ\text{C}$):

V_F	二极管正向压降($T_C=25^\circ\text{C}$)	---	---	2.0	V	$I_F=20A$
T_{rr}	二极管反向恢复时间	---	138	---	ns	$I_F=20A, V_R=400V,$ $diF/dt=200A$
I_R	瞬态反向漏电流	---	---	10	μA	$V_R=600V,$ $T_A=25^\circ\text{C}$

表 3: FRD 电气参数



SYD2065SLA(P,B,D)

IGBT 晶体管 规格书 Rev 0.3

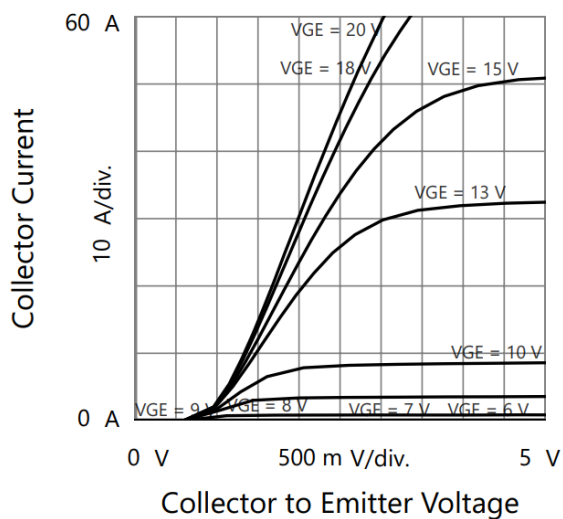
开关特性参数(除非另有说明, $T_A = 25^\circ\text{C}$):

t_{on}	开通延时	---	15	---	ns	$V_{CE}=400V$ $I_C=20A$ $R_g=10\Omega$ $V_{GE}=15V$ 感性负载
t_{off}	关断延时	---	120	---	ns	
T_r	开启上升时间	---	22	---	ns	
T_f	关断下降时间	---	29	---	ns	
E_{on}	导通损耗	---	0.58	---	mJ	
E_{off}	关断损耗	---	0.45	---	mJ	
E_{sw}	开关损耗	---	1.03	---	mJ	

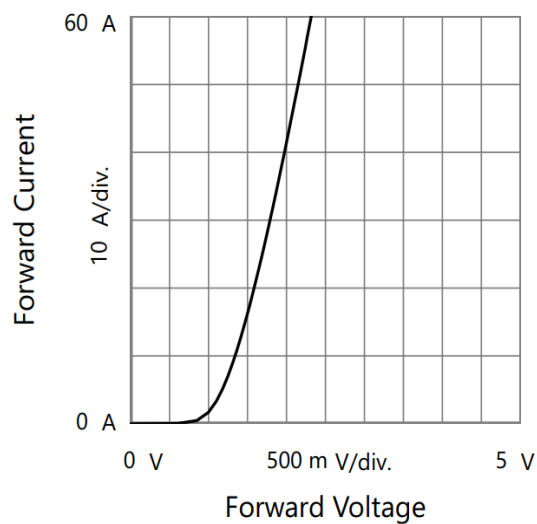
表 4: 开关特性参数

典型特性曲线图(除非另有说明, $T_A = 25^\circ\text{C}$):

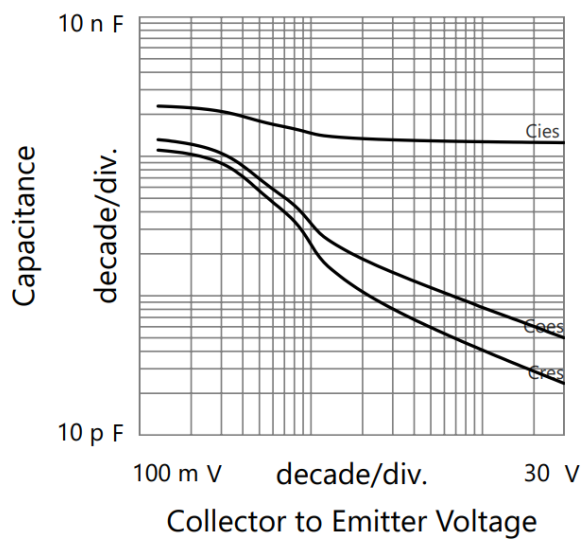
Output Characteristics



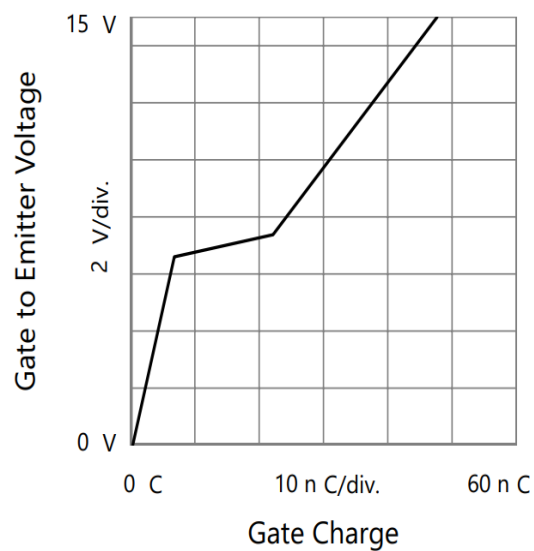
Freewheeling Diode Forward Characteristics



Capacitances

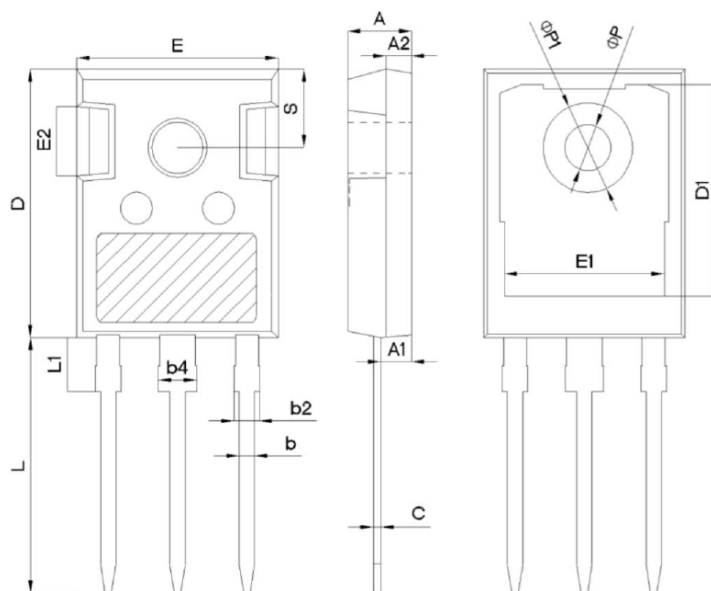


Gate Charge



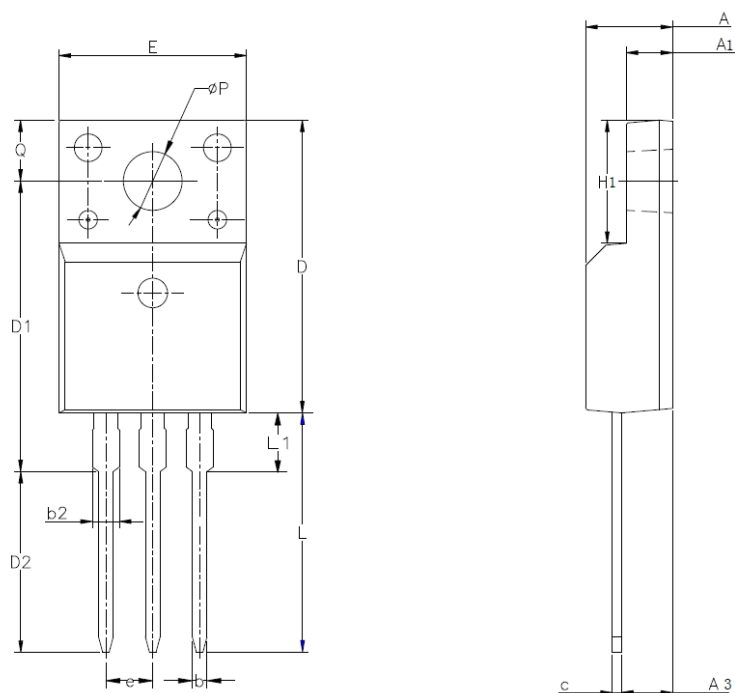
封装信息：

TO-247 封装尺寸图



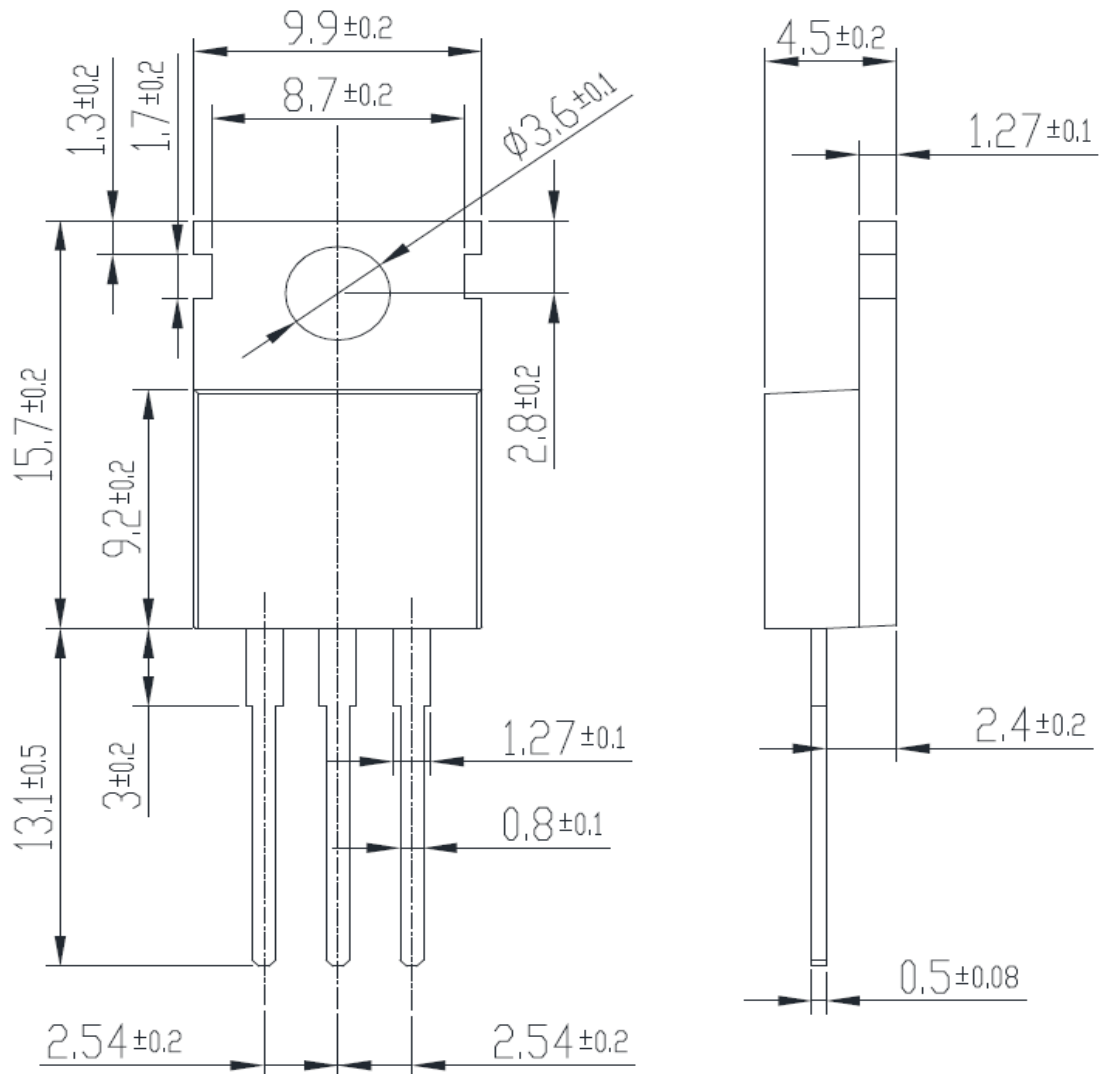
SYMBOL	mm		
	MIN	NOM	MAX
A	4.80	5.00	5.20
A1	2.21	2.41	2.61
A2	1.85	2.00	2.15
b	1.11	1.21	1.36
b2	1.91	2.01	2.21
b4	2.91	3.01	3.21
c	0.51	0.61	0.75
D	20.70	21.00	21.30
D1	16.25	16.55	16.85
E	15.50	15.80	16.10
E1	13.00	13.30	13.60
E2	4.80	5.00	5.20
E3	2.30	2.50	2.70
e	5.44BSC		
L	19.62	19.92	20.22
L1	-	-	4.30
ΦP	3.40	3.60	3.80
$\Phi P1$	-	-	7.30
S	6.15BSC		

TO-220F 封装尺寸图:

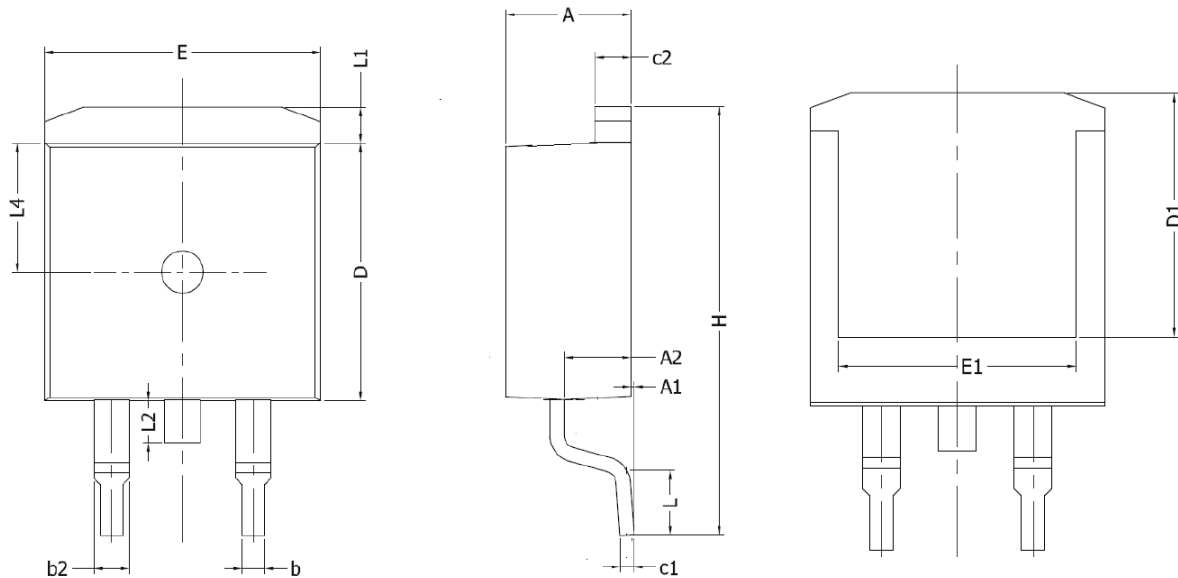


SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.70	0.80	0.90
b2	—	—	1.47
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	15.30	15.75	16.30
D2	9.30	9.80	10.30
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BCS		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	/	/	3.50
ØP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

TO-220 封装尺寸图:



TO-263 封装尺寸图:



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.40	4.60	0.17	0.18
A1	0.00	0.25	0.00	0.01
A2	2.20	2.60	0.09	0.10
b	0.76	0.89	0.03	0.04
b2	1.23	1.37	0.05	0.05
C	0.47	0.60	0.02	0.02
c1	0.46	0.56	0.02	0.02
c2	1.25	1.35	0.05	0.05
D	0.91	0.93	0.04	0.04
D1	8.00	-	0.31	-
E	9.80	10.00	0.39	0.39
E1	7.80	-	0.31	-
e	2.54BSC		0.10BSC	
H	14.90	15.70	0.59	0.62
L	2.00	2.60	0.08	0.10
L1	1.17	1.40	0.05	0.06
L2	-	1.75	-	0.07
L4	4.60REF		0.18REF	